

УДК 621.382.2.3

А.В. Чунарева (6 курс, каф. ФППиНЭ), Н.Д. Ильинская, к.ф.-м.н., с.н.с.

## МЕТОД ВЗРЫВНОЙ ЛИТОГРАФИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

**ABSTRACT:** This work was carried out for creation of photoresist structure for which the edge of metal would be smooth. The method of explosive lithograph and so-called «image reversal» photoresist were used in this work.

Данная работа проводилась для создания такого профиля фоторезиста, чтобы край наносимого металла был бы плавным, при этом использовался метод взрывной литографии [1]. Этот метод состоит из нескольких этапов:

- создание фоторезистной маски со специальным профилем;
- нанесение металла методом вакуумного термического испарения;
- удаление или «взрыв» фоторезиста.

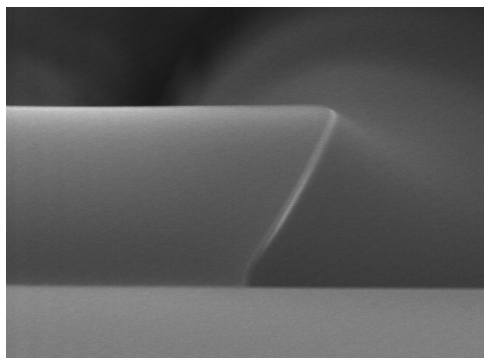


Рис. 1. Профиль фоторезиста марки TI-35ES.

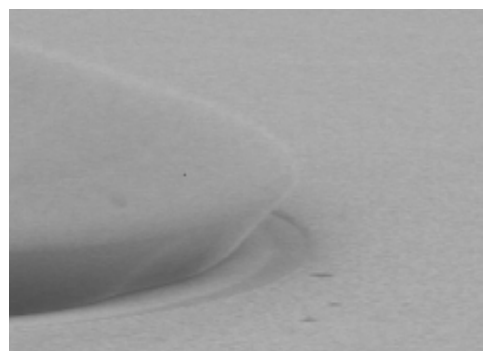


Рис. 2. Фоторезист с нанесенным металлом. Толщина фоторезиста составляет 3 мкм, толщина металла 0,15 мкм.

Результатом проведенной работы стало создание методом взрывной литографии металлического рисунка с плавным краем.

### ЛИТЕРАТУРА:

1. Моро У. Микролитография. – М.: Мир, 1990.